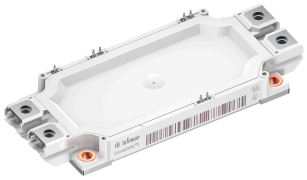
Final datasheet

EconoDUAL™3 Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und PressFIT / NTC

Eigenschaften



- Elektrische Eigenschaften
  - V_{CES} = 1700 V
  - $I_{C\ nom}$ = 750 A / I_{CRM} = 1500 A
  - Integrierter Temperatursensor
  - Hohe Stromdichte
  - Niedriges V_{CEsat}
  - Überlastbetrieb bis zu 175°C
  - Trenchstop™ IGBT7
  - V_{CEsat} mit positivem Temperaturkoeffizienten
  - Verstärkte Diode für Rückspeisebetrieb
  - Geeignete Infineon Gate-Treiber finden Sie unter https://www.infineon.com/gdfinder
- Mechanische Eigenschaften
  - Hohe Leistungsdichte
  - Isolierte Bodenplatte
  - PressFIT Verbindungstechnik
  - Standardgehäuse

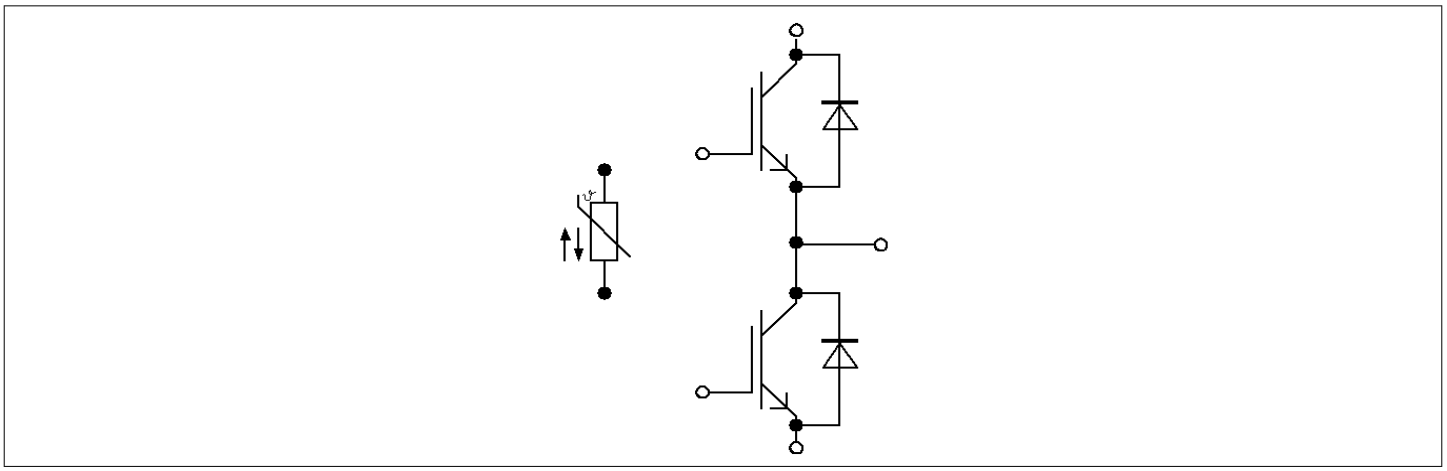
Potenzielle Anwendungen

- Hochleistungsumrichter
- Mittelspannungsantriebe
- Motorantriebe
- Windgeneratoren
- Energieübertragung und -verteilung

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

Beschreibung 1
Eigenschaften 1
Potenzielle Anwendungen 1
Produktvalidierung 1
Inhalt 2
1 Gehäuse 3
2 IGBT, Wechselrichter 4
3 Diode, Wechselrichter 6
4 NTC-Widerstand 7
5 Kennlinien 8
6 Schaltplan 13
7 Gehäuseabmessungen 14
8 Modul-Label-Code 15
Änderungshistorie 16
Disclaimer 17

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	3.4	kV
Isolationsprüfspannung NTC	$V_{ISOL(NTC)}$	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	3.4	kV
Material Modulgrundplatte			Cu	
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Kriechstrecke	$d_{Creep\ nom}$	Kontakt - Bodenplatte, nom.	> 15	mm
Kriechstrecke	$d_{Creep\ min}$	Kontakt - Bodenplatte, min.	14.7	mm
Kriechstrecke	$d_{Creep\ nom}$	Kontakt - Kontakt, nom.	> 19.3	mm
Kriechstrecke	$d_{Creep\ min}$	Kontak - Kontakt, min.	19.3	mm
Luftstrecke	$d_{Clear\ nom}$	Kontakt - Bodenplatte, nom.	> 12.5	mm
Luftstrecke	$d_{Clear\ min}$	Kontakt - Bodenplatte, min.	12.5	mm
Luftstrecke	$d_{Clear\ nom}$	Kontakt - Kontakt, nom.	> 10	mm
Luftstrecke	$d_{Clear\ min}$	Kontak - Kontakt, min.	9.6	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	*CTI*		> 200	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	*RTI*	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}				20		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	T_C = 25 °C, pro Schalter			0.8		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}			-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	*M*	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M5, Schraube	3		6	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	*M*	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M6, Schraube	3		6	Nm
Gewicht	*G*				345		g

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	1700	V
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_C = 80 °C	750	A
Grenzeffektivstrom der Modul DC-Kontakte	I_{tRMS}		$T_{Terminal}$ = 90 °C, T_C = 90 °C	580	A
			$T_{Terminal}$ = 105 °C, T_C = 90 °C	565	
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\,op}$		1500	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			±20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\,sat}$	I_C = 750 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.70	1.85	V
			T_{vj} = 125 °C		1.95		
			T_{vj} = 150 °C		2.05		
			T_{vj} = 175 °C		2.10		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	I_C = 15.7 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 900 V, T_{vj} = 25 °C			7.15		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			0.33		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			78.1		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.275		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	V_{CE} = 1700 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			5	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	I_C = 750 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 0.51 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.158		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.172		
			T_{vj} = 150 °C		0.178		
			T_{vj} = 175 °C		0.184		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_C = 750 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 0.51 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.046		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.053		
			T_{vj} = 150 °C		0.055		
			T_{vj} = 175 °C		0.057		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	I_C = 750 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 2.2 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.536		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.613		
			T_{vj} = 150 °C		0.631		
			T_{vj} = 175 °C		0.648		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_C = 750 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 2.2 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.231		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.450		
			T_{vj} = 150 °C		0.525		
			T_{vj} = 175 °C		0.599		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_C = 750 A, V_{CC} = 900 V, L_σ = 25 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 0.51 Ω, di/dt = 11.1 kA/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		74		mJ
			T_{vj} = 125 °C		171		
			T_{vj} = 150 °C		204		
			T_{vj} = 175 °C		238		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_C = 750 A, V_{CC} = 900 V, L_σ = 25 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 2.2 Ω, dv/dt = 3600 V/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		132		mJ
			T_{vj} = 125 °C		208		
			T_{vj} = 150 °C		224		
			T_{vj} = 175 °C		239		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	V_{GE} = 15 V, V_{CC} = 1000 V, V_{CEmax}=V_{CES}-L_{sCE}*di/dt	t_P ≤ 8 µs, T_{vj}=150 °C		2600		A
			t_P ≤ 6 µs, T_{vj}=175 °C		2500		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro IGBT				0.0551	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro IGBT, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			0.0345		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

***Hinweis**: T_{vjop} > 150 °C ist nur im Überlastbetrieb zulässig. Detailierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.*

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1700	V
Implementierter Durchlassstrom	I_{FN}			1200	A
Dauergleichstrom	I_F			750	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	t_P = 1 ms		1500	A
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	48300	A^2s
			T_{vj} = 175 °C	37200	

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 750 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		2.00	2.15	V
			T_{vj} = 125 °C		1.85		
			T_{vj} = 150 °C		1.80		
			T_{vj} = 175 °C		1.75		
Rückstromspitze	I_{RM}	V_{CC} = 900 V, I_F = 750 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 11,8 kA/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		950		A
			T_{vj} = 125 °C		1020		
			T_{vj} = 150 °C		1020		
			T_{vj} = 175 °C		1020		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	V_{CC} = 900 V, I_F = 750 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 11,8 kA/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		115		µC
			T_{vj} = 125 °C		218		
			T_{vj} = 150 °C		255		
			T_{vj} = 175 °C		292		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	V_{CC} = 900 V, I_F = 750 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 11,8 kA/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		76		mJ
			T_{vj} = 125 °C		132		
			T_{vj} = 150 °C		152		
			T_{vj} = 175 °C		171		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode				0.0753	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode, λ_{grease} = 1 W/(m·K)			0.0363		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

***Hinweis**: $T_{vj\ op}$ > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.*

4 NTC-Widerstand

Tabelle 7 Charakteristische Werte

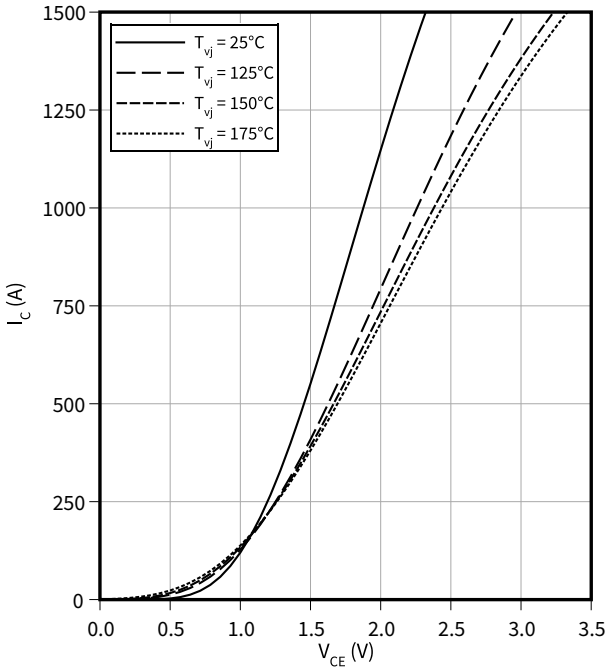
Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Nennwiderstand	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2\text{-}1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2\text{-}1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2\text{-}1/(298{,}15\ K))]$		3433		K

***Hinweis**: Eine detaillierte Beschreibung der NTC-Eigenschaften finden Sie in der AN2009-10, Kapitel 4*

5 Kennlinien

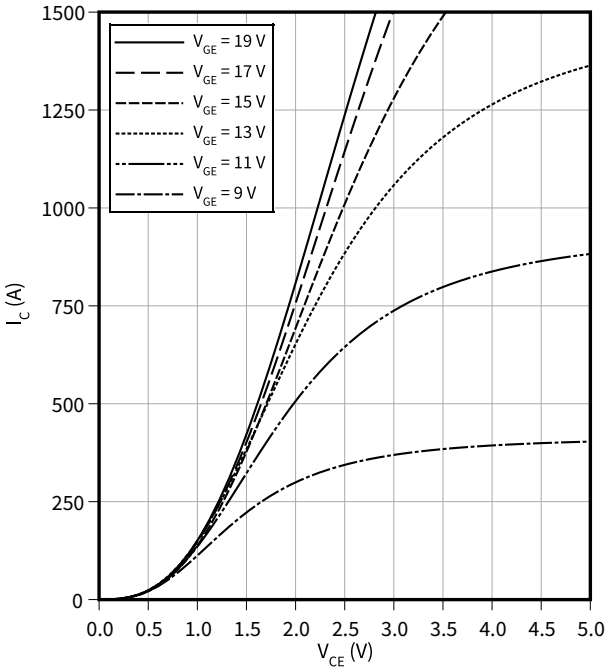
Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$
$V_{GE} = 15$ V



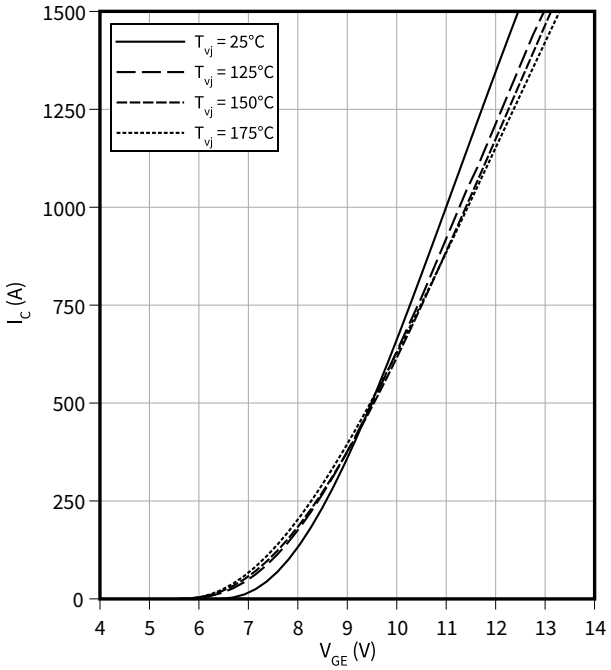
Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$
$T_{vj} = 175$ °C



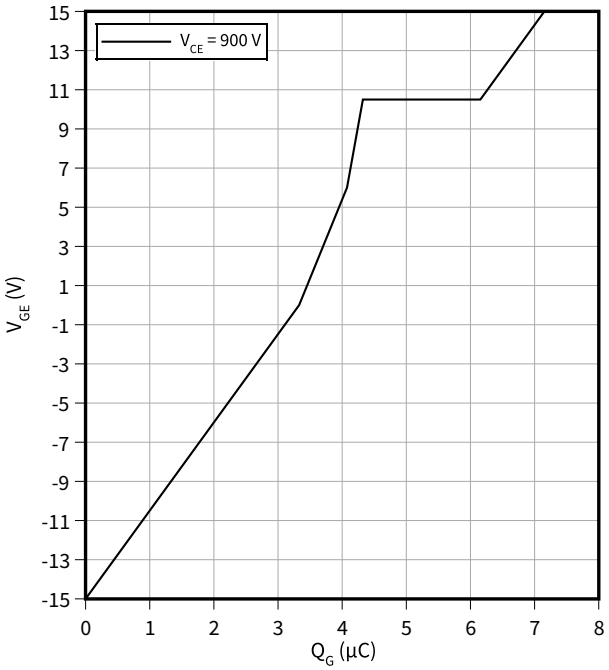
Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{GE})$
$V_{CE} = 20$ V



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

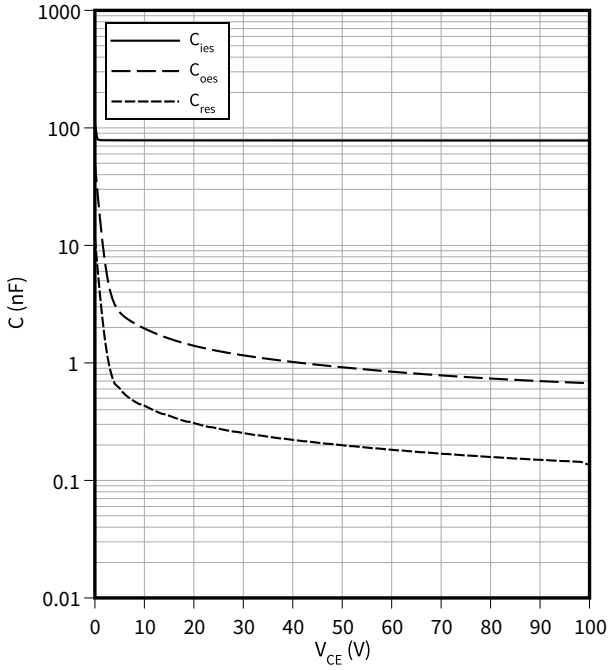
$V_{GE} = f(Q_G)$
$I_C = 750$ A, $T_{vj} = 25$ °C



Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$C = f(V_{CE})$

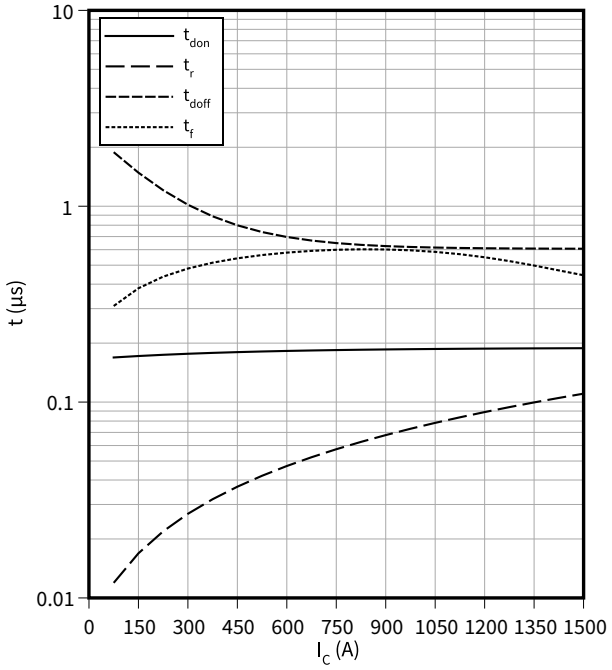
$f = 100\ kHz$, $V_{GE} = 0\ V$, $T_{vj} = 25\ °C$



Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(I_C)$

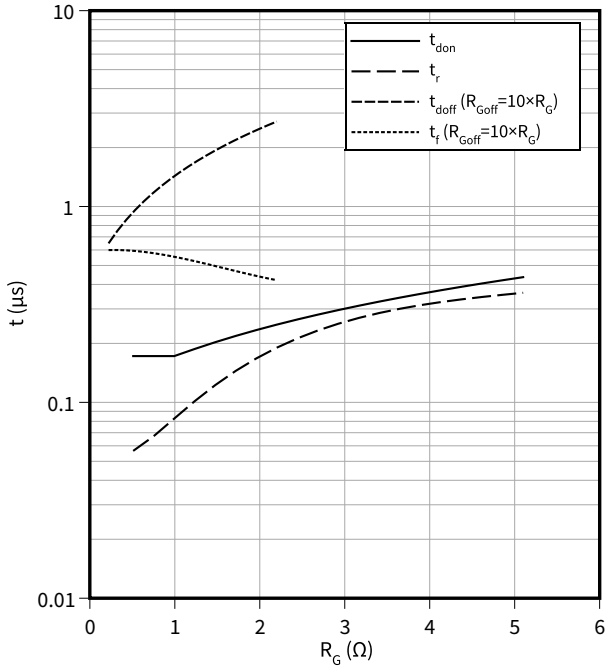
$R_{Goff} = 2.2\ \Omega$, $R_{Gon} = 0.51\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $V_{CC} = 900\ V$, $T_{vj} = 175\ °C$



Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(R_G)$

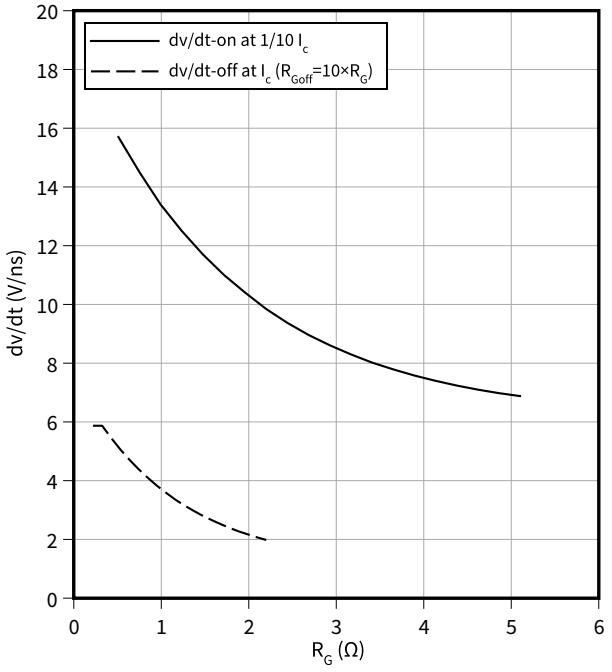
$V_{GE} = \pm 15\ V$, $I_C = 750\ A$, $V_{CC} = 900\ V$, $T_{vj} = 175\ °C$



Spannungssteilheit (typisch), IGBT, Wechselrichter

$dv/dt = f(R_G)$

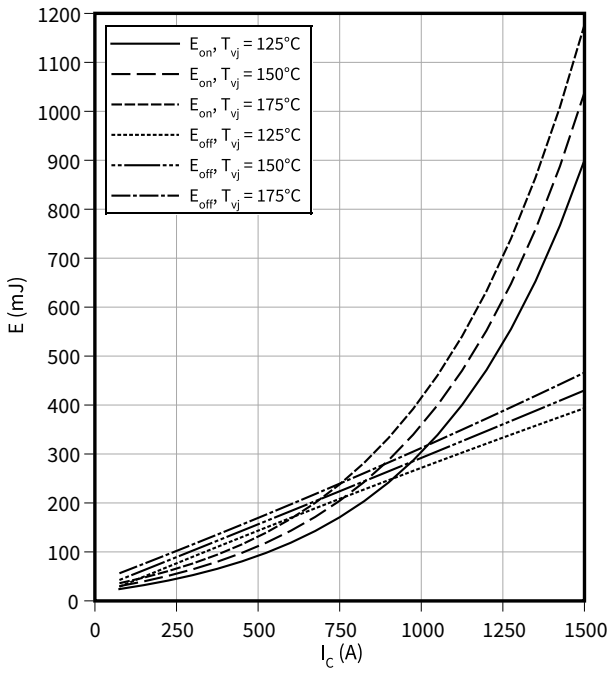
$V_{GE} = \pm 15\ V$, $I_C = 750\ A$, $V_{CE} = 900\ V$, $T_{vj} = 25\ °C$



Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(I_C)$

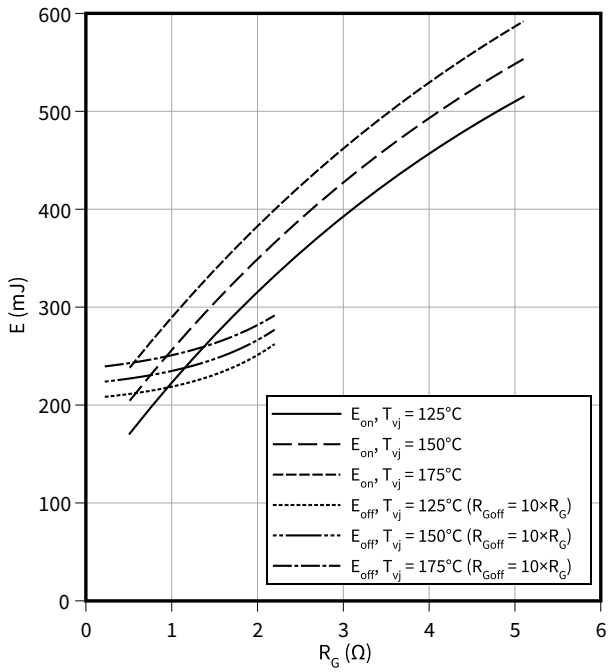
$R_{Goff} = 2.2\ \Omega$, $R_{Gon} = 0.51\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $V_{CC} = 900\ V$



Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(R_G)$

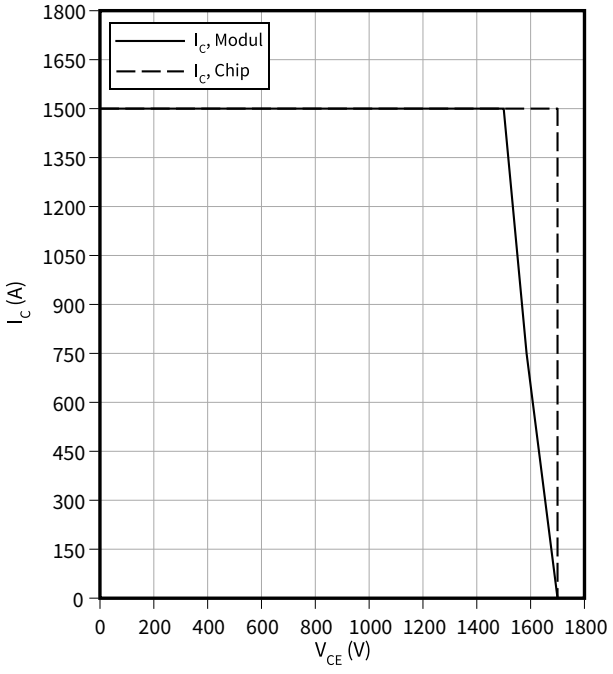
$V_{GE} = \pm 15\ V$, $I_C = 750\ A$, $V_{CC} = 900\ V$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter

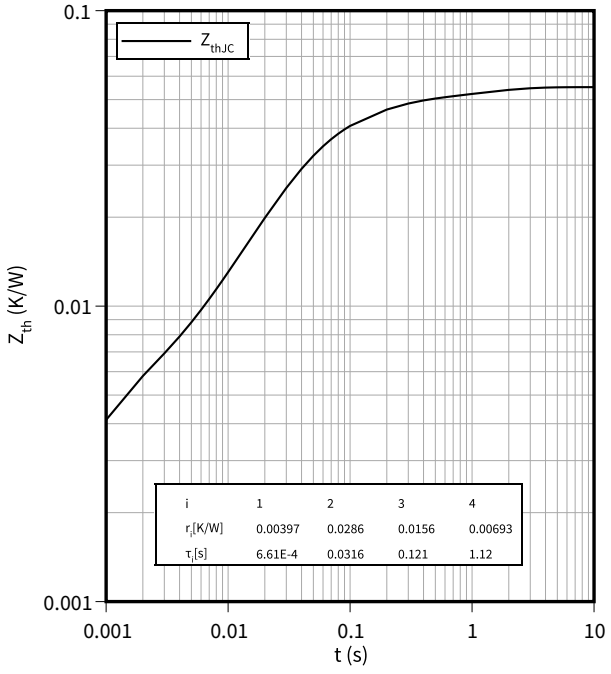
$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 2.2\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\ V$, $T_{vj} = 175\ °C$



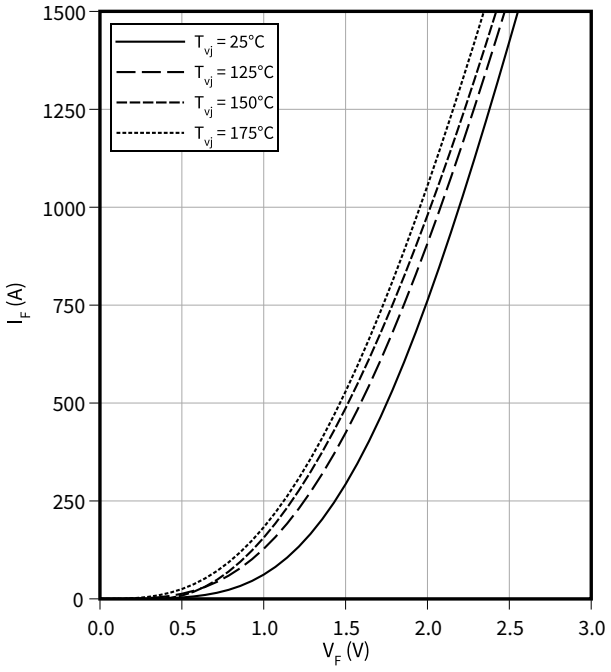
Transient thermal impedance, IGBT, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Wechselrichter

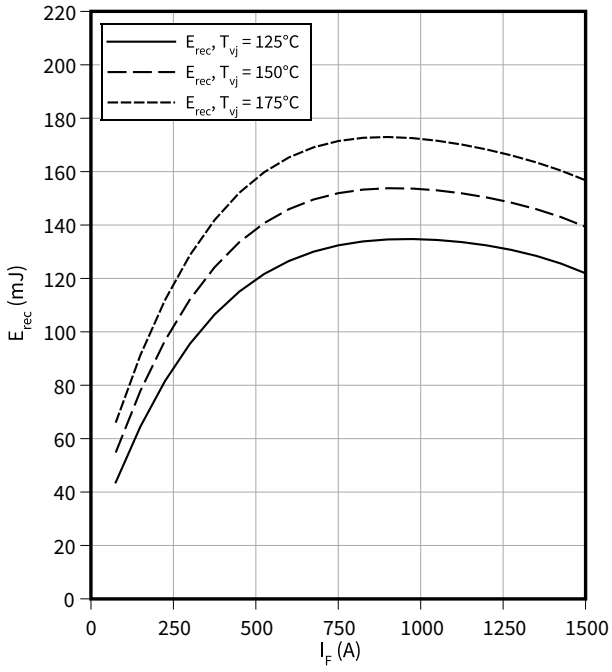
$I_F = f(V_F)$



Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(I_F)$

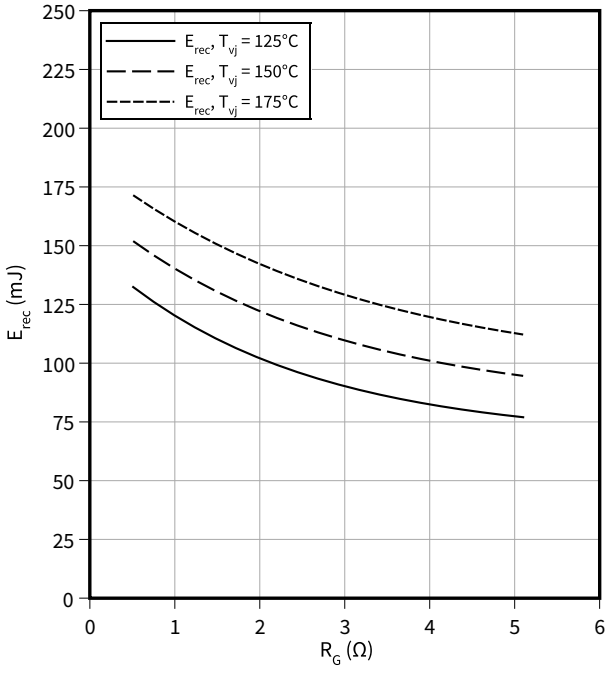
$R_{Gon} = 0.51\ \Omega$, $V_{CC} = 900\ V$



Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

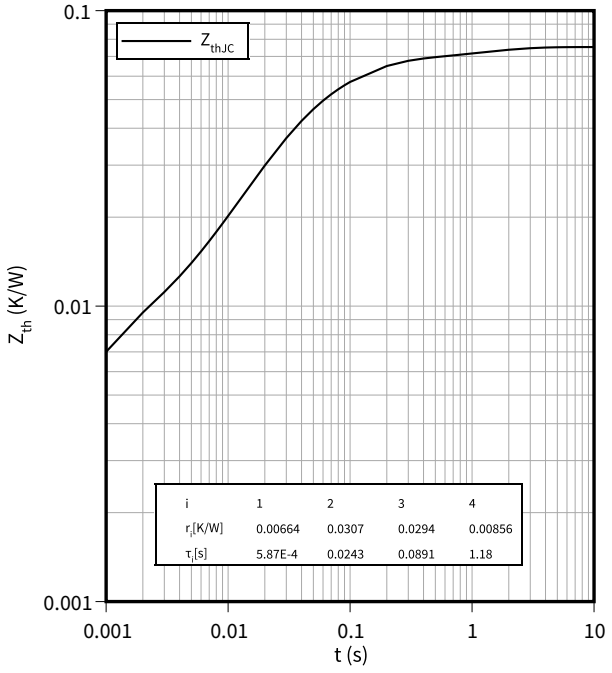
$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 750\ A$, $V_{CC} = 900\ V$



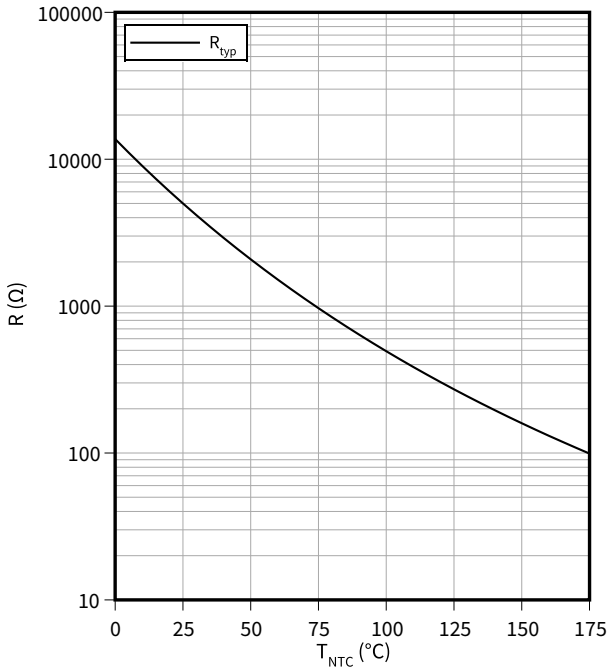
Transient thermal impedance, Diode, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



6 Schaltplan

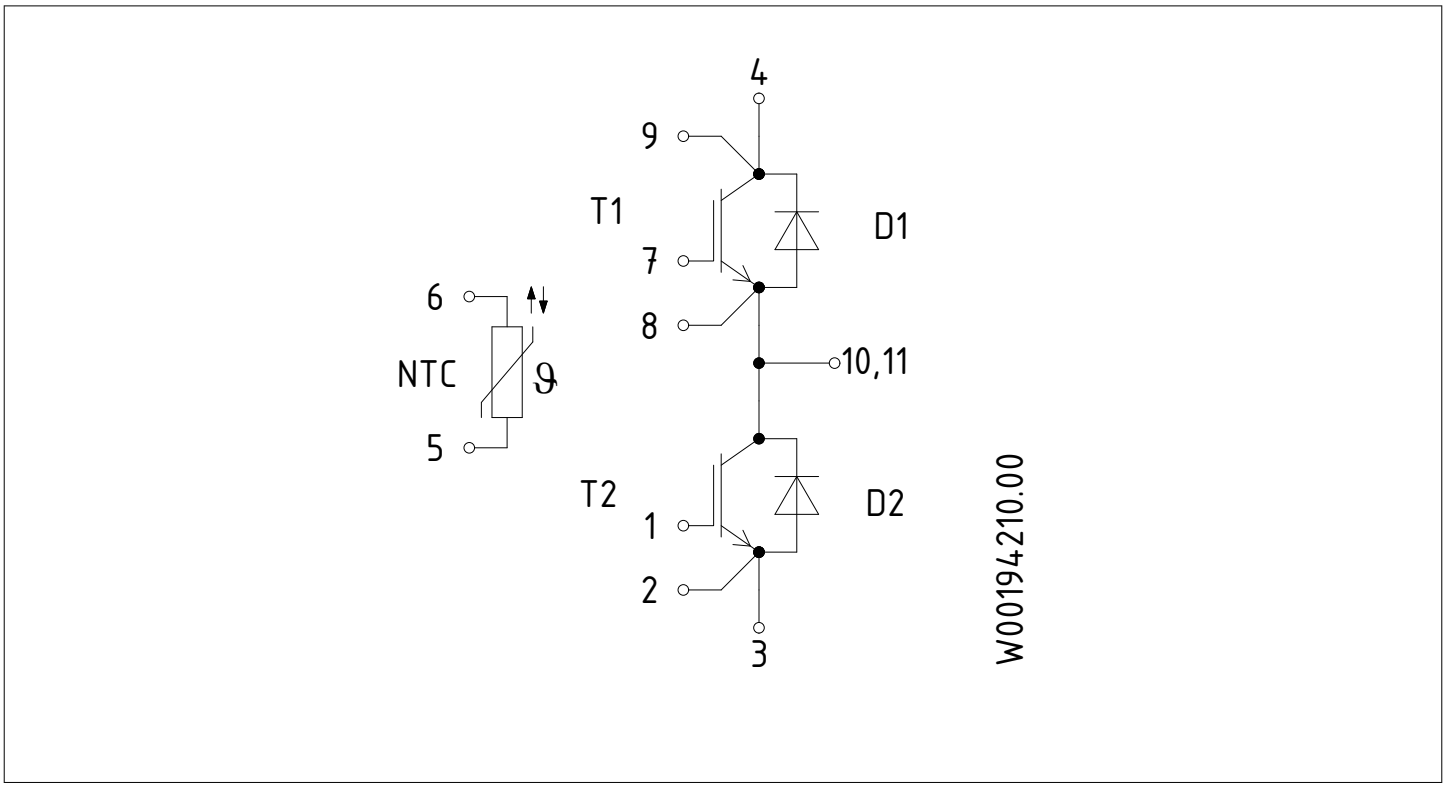


Abbildung 1

7 Gehäuseabmessungen

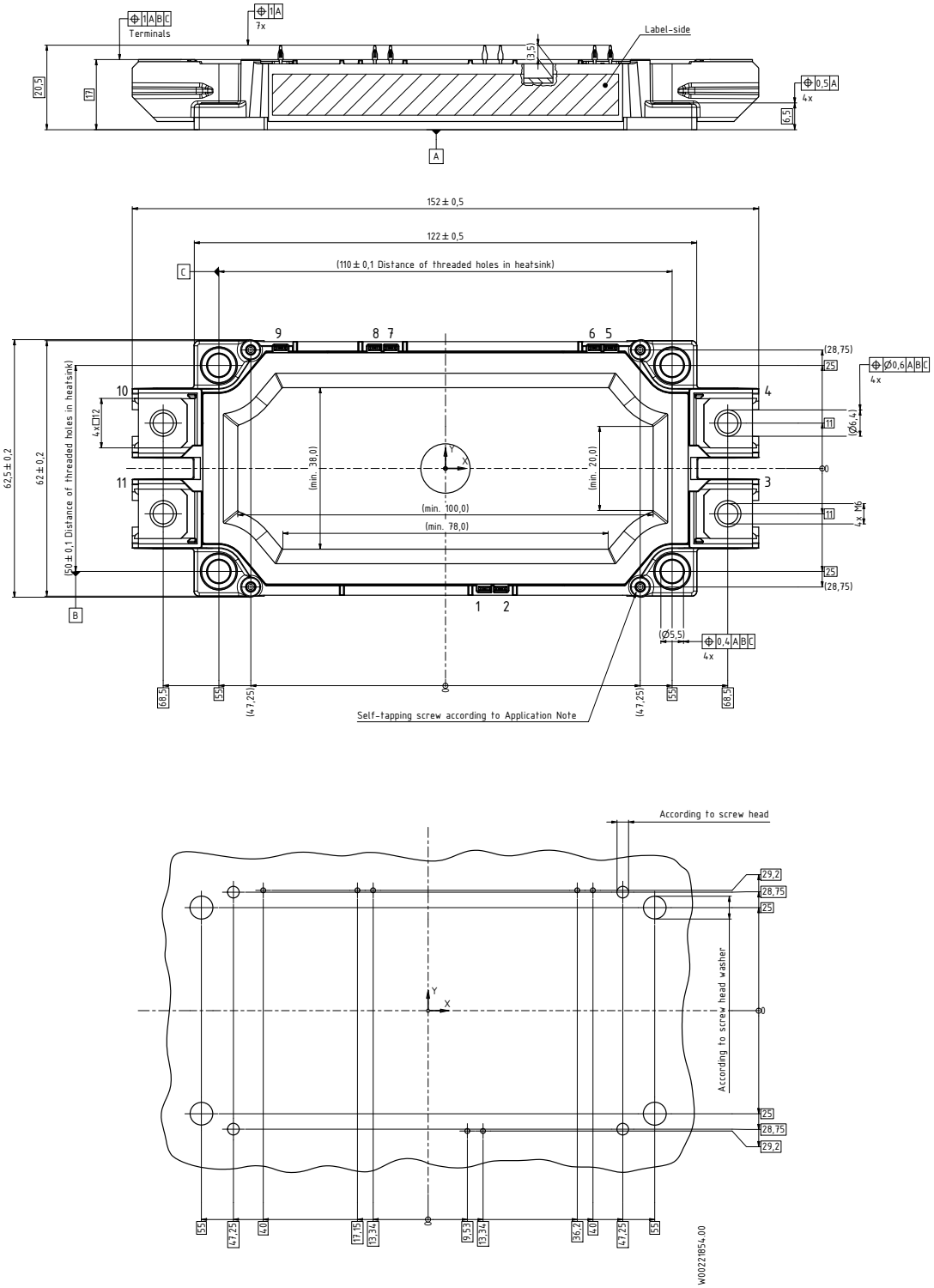


Abbildung 2

8 Modul-Label-Code

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	7154914284655054991530		7154914284655054991530

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
0.10	2021-10-20	Initial version
1.00	2022-05-06	Final datasheet
1.10	2024-03-08	Final datasheet
1.20	2025-08-11	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-08-11

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABB561-004

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.